## ターゲット交換法により作製した BaZrO<sub>3</sub> 添加 SmBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub> 薄膜の超伝導特性 Superconducting properties of the BaZrO<sub>3</sub> doped SmBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub> thin films prepared by Alternating Targets technique. 名大工<sup>1</sup>, 九工大<sup>2</sup> 電中研<sup>3</sup>, <sup>o</sup>高平 俊輔<sup>1</sup>, 吉田 隆<sup>1</sup>, 一野 祐亮<sup>1</sup>, 松本 要<sup>2</sup>, 一瀬 中<sup>3</sup> Nagoya Univ.<sup>1</sup>, Kyushu Inst. Tech.<sup>2</sup>, CRIPEI<sup>3</sup>, <sup>o</sup>Shunsuke Takahira<sup>1</sup>, Yutaka Yoshida<sup>1</sup>,

Nagoya Univ. , Kyusnu Inst. Iech.<sup>-</sup>, CRIPEI<sup>-</sup>, Shunsuke Takahira<sup>-</sup>, Yutaka Yoshida<sup>-</sup>, Yusuke Ichino<sup>1</sup>, Kaname Matsumoto<sup>2</sup>, Ataru Ichinose<sup>3</sup> E-mail: takahira.syunsuke@e.mbox.nagoya-u.ac.jp

## 1. はじめに

**REBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub>(REBCO)薄膜の c 軸方向に対して平行に印加された磁場中において超伝導特性を向上させる手法として、BaMO<sub>3</sub> (BMO; M=Zr,Sn など)ナノロッドの導入が効果的である<sup>[1]</sup>。我々は、ターゲット交換法を用いて BaSnO<sub>3</sub>(BSO)及び BaHfO<sub>3</sub>(BHO)を SmBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub>(SmBCO)薄膜にナノロッドとして導入した際の、高 T\_c及び磁場中高 J\_cを報告してきた<sup>[2][3]</sup>。BMO の M 元素の違いによるナノロッド成長メカニズムや超伝導層への影響を理解することは、さらなる高特性化に重要と考えられる。そこで本研究では、ターゲット交換法を用いて、SmBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>y</sub>薄膜に BaZrO<sub>3</sub>(BZO)を導入して BZO 添加 SmBCO 薄膜(SmBCO+BZO)を作製し、超伝導特性の評価を行った。** 

## 2. 実験方法

SmBCO+BZO 薄膜は、KrF エキシマレーザーを用 いて PLD 法により LaAlO<sub>3</sub>(LAO)基板上に成膜を行 った。BZO の添加には、SmBCO と BZO のターゲ ットに対して交互にレーザーを照射して BZO 添加 量を制御するターゲット交換法を用いた。ここで、 各ターゲットへのレーザーパルス数比を変えるこ とにより、BZO 添加量を制御した。薄膜の結晶性、 配向性を X 線回折法(XRD)、超伝導特性については 直流四端子法を用いて測定した。

## 3. 実験結果及び考察

XRD 測定の結果より、作製した薄膜は二軸配向 を示した。

Fig. 1 に 77K、B//c における J。の磁場依存性を示 す。最も高い超伝導特性を示した BZO 3.0 vol.%添 加 SmBCO 薄膜は、pure-SmBCO 薄膜の Tc=92.6 K と同程度である T<sub>c</sub>=92.1 K、自己磁場下における J<sub>c</sub> (J<sub>c</sub><sup>self</sup>)=3.86 MA/cm<sup>2</sup>を示した。さらに、自己磁場下 だけでなく、全磁場領域においても pure-SmBCO 薄 膜に比べて J<sub>c</sub>の向上が見られた。また、BZO の添 加量が増加するに従い、0.2~2 Tに見られる平坦な 領域が広くなることが確認される。これは、BZO の添加量が増えたことによりピンニング力が増加 したためであると推察される。一方、添加量が 4.9 vol.% の場合、添加量が 3.0 vol.% に比べて BZO ナ ノロッドが増えることによって、格子ミスフィット による引っ張り応力が大きくなり、J<sub>c</sub><sup>self</sup>低下が確認 された。Fig. 2 に、Fig. 1 から算出した巨視的ピンニ ングカ $F_p$ の磁場依存性を示す。 $F_p$ の最大値は、

pure-SmBCO 薄膜が 2.82 GN/m<sup>3</sup> であるのに対し、 BZO 3.0 vol.%添加 SmBCO 薄膜では 28.0 GN/m<sup>3</sup>、 BZO 4.9 vol.%添加 SmBCO 薄膜では 25.1 GN/m<sup>3</sup>が 得られた。また、 $F_p$ の最大値を示す磁場は、 $J_c$ の磁 場依存性における平坦領域の終端と等しいことが 確認された。今後、透過型電子顕微鏡(TEM)を用い て微細構造観察を行い、磁束ピンニング特性を詳細 に検討し、BHO 及び BSO 添加 SmBCO 薄膜との比 較も行う予定である。



Fig. 1 Magnetic field dependence of  $J_c$  for the BZO-doped SmBCO films.



Fig. 2 Magnetic field dependence of the macroscopic pinning forces of the BZO-doped SmBCO films. 謝辞

本研究の一部は、科学研究費補助金(23226014, 19676005)の助成を受けて実施したものである。 参考文献

- [1]P. Mele *et al.*: Supercond. Sci. Technol. Vol. 21 (2008) 032002.
- [2]A. Tsuruta et al.: ICEC24-ICMC2012 15P-P08-08.
- [3]A. Tsuruta et al.: ASC2012 2MPR-05